

# 2SB1374

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ  
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors  
低周波増幅用/Low Freq. Power Amp.

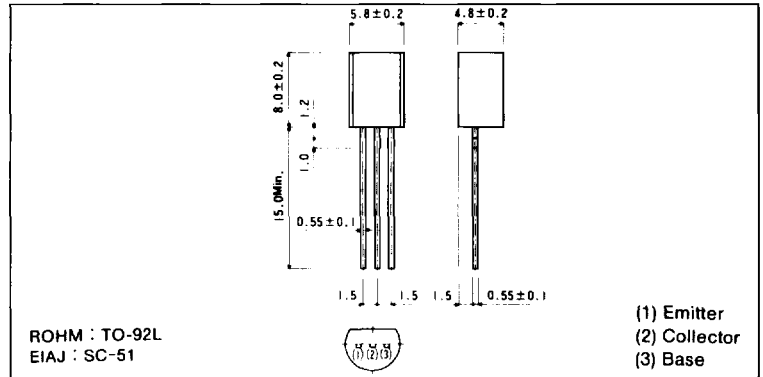
## ● 特長

- 1)  $V_{CE(sat)}$  が低い。  
 $V_{CE(sat)} = -0.35V$  (Max.)  
( $I_C/I_B = -1A/-50mA$ )
- 2) 直流電流増幅率  $h_{FE}$  の電流特性が優れている。

## ● Features

- 1) Low  $V_{CE(sat)}$   
 $V_{CE(sat)} = -0.35V$  (Max.)  
( $I_C/I_B = -1A/-50mA$ )
- 2) Excellent current characteristics of DC current amplification factor  $h_{FE}$

## ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-6	V
コレクタ電流	$I_C$	-2	A(DC)
		-5	A(Pulse)*
コレクタ損失	$P_C$	1	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度範囲	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$

\* Single pulse  $P_W = 10ms$ ● 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CBO}$	-50	-	-	V	$I_C = -50 \mu A$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CEO}$	-50	-	-	V	$I_C = -1mA$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EBO}$	-6	-	-	V	$I_E = -50 \mu A$
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	-	-	-0.1	$\mu A$	$V_{CB} = -50V$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	-	-	-0.1	$\mu A$	$V_{EB} = -5V$
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	82	-	270	-	$V_{CE}/I_C = -2V/-0.5A$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}^*$	-	-0.15	-0.35	V	$I_C/I_B = -1A/-50mA$
利得帯域幅積	$f_T$	-	200	-	MHz	$V_{CE} = -2V, I_E = 0.5A, f = 100MHz$
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	-	36	-	pF	$V_{CB} = -10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

\* パルス測定

 $h_{FE}$  の値により下表のように分類します。

Item	P	Q
$h_{FE}$	82~180	120~270

● 標準品・準標準品一覧表

(○)：準標準品

Type	hFE	包装名	バルク	テーピング
		記号		T103
		基本発注単位(個)	1000	2500
2SB1374	PQ		(○)	(○)

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

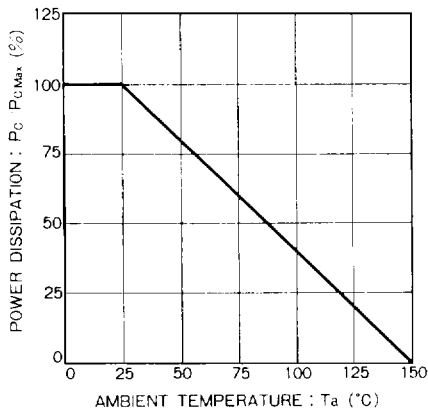


Fig. 1 電力軽減曲線

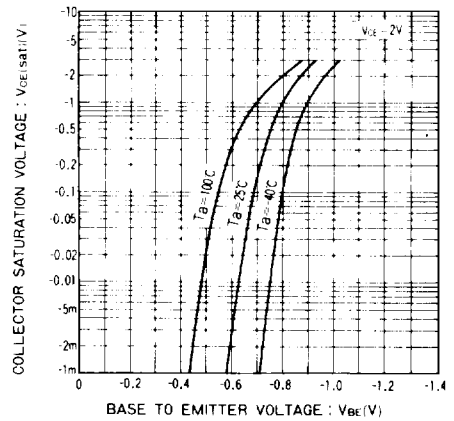


Fig. 2 エミッタ接地伝達静特性

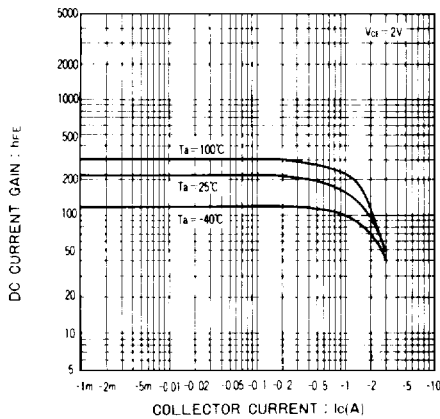


Fig. 3 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

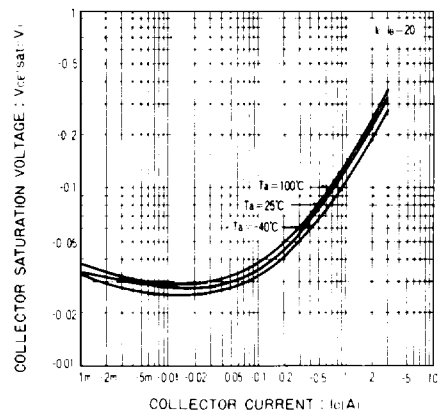


Fig. 4 コレクタ・エミッタ飽和電圧-コレクタ電流特性